川井哲郎・武田 茂*・大竹 充・二本正昭** (横浜国大, *Magnontech, **中央大) Gilbert damping constant of Fe-Al(001) single-crystal films Tetsuroh Kawai, Shigeru Takeda, Mitsuru Ohtake, and Masaaki Futamoto (Yokohama National University, *Magnontech, Ltd., **Chuo University)

はじめに スピントロニクスの進展に伴い磁性薄膜の Gilbert ダンピング定数を精度良く測定することの重要性 が増している¹⁾.磁場掃引強磁性共鳴の吸収幅(ΔH)から Gilbert ダンピング定数を求める方法は良く知られてい る²⁾.本報告では Fe-A(001)単結晶薄膜を例として,周波 数掃引強磁性共鳴の吸収幅($\Delta \omega$)から Gilbert ダンピン グ定数を求める方法について報告する.Fe-Al 合金薄膜は 幅広く実用化されているだけでなく,軟磁気特性に優れ ているので $\Delta \omega$ に及ぼすさまざまな要因を分離しやすい と考え測定試料に選んだ.

実験方法 Fe-Al 合金ターゲットを使用して UHV RF マ グネトロンスパッタ法で MgO(001)単結晶基板上に厚さ 40 nm の膜を作製した. 基板温度は 300 °C の一定温度と した. 膜の構造が bcc(001)単結晶膜であることを RHEED と XRD で確認した. 1 kOe までの静磁場を膜面内に印加 して周波数掃引で強磁性共鳴(FMR)の測定を行なった³⁾. 最大周波数は 10 GHz である. 共鳴吸収の半値幅 (2 $\Delta \omega$) を ΔH に換算して Gilbert ダンピング定数を求めた.

実験結果と考察 Fe₈₀Al₂₀(001)単結晶薄膜の困難軸方向 (//bcc[110]) に1 kOe までの静磁場を印加した時の共鳴 周波数(f_r)の磁場依存性を Fig. 1 に示す. 異方性磁場近く で f.が一旦小さくなり, さらに磁場が大きくなるとそれ につれて f. も大きくなるという典型的な単結晶膜の挙動 を示している. 充分飽和していると考えられる 845 Oeの 静磁場を印加した時の FMR 測定例を Fig. 2 に示す. 実線 は LLG 方程式の解から計算した値を示す(計算に使った パラメーターは図中に記載).一見、ダンピング定数 a=0.009 で実験と計算が良く一致しているように見える. しかし、 $\Delta \omega$ には Gilbert ダンピング定数だけでなくさま ざまな外部因子の影響も含まれることが知られている. そこで、磁場掃引の場合と同様な解析を行うため、Δω をΔH に換算し,充分飽和していると考えられる領域で ΔHのf,依存性を示したのがFig.3である.直線近似した 傾きから算出した Gilbert ダンピング定数はa=0.005 程度 である.本実験ではfrに依存しないΔHoが 30 Oe 程度と大 きな値となった. 今後はこのようにΔH₀ が大きくなった 原因を明らかにする.

参考文献

- J. C. Slonczewski, J. Magn. Magn. Matter., 159, L1 (1996).
- 2) S. S. Kalarickal et al., J. Appl. Phys., 99, 093909 (2006).
- S. Takeda and H. Suzuki, J. Magn. Soc. Jpn., 33, 171 (2009).



Fig. 1 Static magnetic field dependence of resonant frequency measured for an $Fe_{80}Al_{20}(001)$ single-crystal film.



Fig. 2 Measured complex permeability for the $Fe_{80}Al_{20}(001)$ single-crystal film. Circles are experiments and the solid lines are calculations.



Fig. 3 Resonant frequency dependence of ΔH of the Fe₈₀Al₂₀(001) single-crystal film.